PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-255518

(43) Date of publication of application: 11.09.2002

(51)Int.CI.

C01B 31/02

(21)Application number: 2001-054344

(71)Applicant: JAPAN ATOM ENERGY RES INST

(22)Date of filing:

28.02.2001

(72)Inventor: WATANABE SATOSHI

ISHIOKA NORIKO SEKINE TOSHIAKI

CHO AKIHIKO

KOIZUMI MITSUO

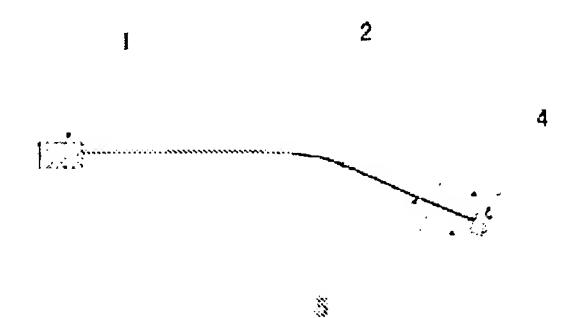
MURAMATSU HISAKAZU SHIMOMURA HARUHIKO YOSHIKAWA HIROSUKE

(54) PRODUCTION METHOD FOR FULLERENE SELECTIVELY INCLUDING ISOTOPE ATOM BY ION IMPLANTATION METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method by which a radioactive isotope is included into fullerene by an ion implantation method.

SOLUTION: The production method for fullerene including a specific isotope such as a radio active isotope is a method implanting the isotope using fullerene or a fullerene derivative as a target and an ion injector equipped with a mass spectrometry magnet.



JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS
[Claim(s)] [Claim 1]A manufacturing method of atomic intension fullerene targeting fullerene and a fullerene derivative and carrying out the ion implantation of the specific isotopes, such as radioisotope, using an ion-implantation machine equipped with a mass analysis magnet.
an ion-implantation machine equipped with a mass analysis magnet.

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention]This invention relates to making fullerene include radioisotope etc. lon implantation is used in order to manufacture isotope intension fullerene.

[0002]

[Description of the Prior Art]As a manufacturing method of intension fullerene using ion implantation, alkali element intension fullerene (Tellgmann R. et al., Nature 382, and 407-408 (1996).), such as Li N intension fullerene (Weidinger A. et al., Appl. Phys. A 66, and 287-292) and (1998) helium, Ne intension fullerene (Shimshi R. et al., J. Am. Chem. Soc. 119, and 1163-1164) (1997) etc. are reported. These are all the manufacturing methods about non-isotope alternative intension fullerene. The manufacturing method of the fullerene which included Xe-127 which is a radioactive isotope of a xenon, The thing (Ohtsuki T. et al. and Physical Review Letters 81,967-970 (1998)) using the anti-** energy in a 127 I(d, two n) 127 Xe reaction is reported.

[0003]However, when a nuclear reaction is used, radioisotope intension fullerene other than the purpose may generate. The target isotope is included in a carbon rod electrode, and the method of manufacturing isotope intension fullerene by arc discharge process is reported (Ambe F., J. Radioanal. Nucl. Chem. 243, and 21-25 (2000)). However, various-sorts generation of the fullerene kind of metallofullerene made by this method cannot be carried out, and it cannot make intension fullerene of arbitrary fullerene kinds.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]although the manufacturing method of Li by an ion implantation, N, helium, and Ne intension fullerene is reported as a Prior art -- these -- all -- a non-isotope -- it is alternative. Although the manufacturing method of radioisotope intension fullerene using a nuclear reaction is reported, isotope intension fullerene other than the purpose cannot generate, and single isotope intension fullerene cannot be made.

[0005]Although the manufacturing method of isotope intension fullerene using arc discharge process is reported, This cannot generate intension fullerene of arbitrary fullerene kinds (in addition to this, existence of many fullerene kinds is clear including fullerene derivatives, such as C_{60} , C_{70} , and C_{82}).

Then, this invention is originated in order to solve these problems.

[0006]

[Means for Solving the Problem] This invention can manufacture intension fullerene which does not contain any isotopes other than the purpose by using an ion-implantation machine in which an ion implantation of a single isotope is possible. Intension fullerene of arbitrary fullerene kinds can be manufactured from the ability of fullerene kinds arbitrary as a target of an ion implantation to be chosen.

[0007]

[Embodiment of the Invention]In order to carry out the ion implantation of the single isotope by this invention about an ion implantation with an ion-implantation machine, the ion-implantation machine (drawing 1) provided with the mass analysis magnet is used. The outline of the ion-implantation machine is shown below. The target 4 is installed in the target chamber 3 of an ion-implantation machine, and an ion implantation is performed in a vacuum. At this time, various ion generated by the ion source 1 is carried by the mass analysis magnet 2 as an ion beam. Since mass separation of an ion beam is performed here, the ion implantation only of the target isotope ion beam 5 is carried out to the target 4.

[0008]As a target of an ion implantation, arbitrary fullerene kinds also including a fullerene derivative are used about a target. The ion-implantation machine used by this invention is usually worked by 40 keV in order to carry out mass separation of the specific isotope, but since it is too high as incidence energy of isotope ion when manufacturing isotope intension fullerene, the ion needs to be slowed down. Then, how [two] the retardation methods shown below differ are used.

- (1) Mix fullerene and a moderator (powder, such as CsI) at an arbitrary rate, create the target of a pellet type, and perform the ion implantation of an isotope to this.
- (2) Vapor-deposit fullerene to a metallic foil and create a thin film target. The slit which applied the voltage of + to the front face of this thin film target as a reduction gear is installed, and the ion implantation of an isotope is performed. Xe-133 which is radioisotope is mentioned as an example below, and the concrete example of this invention is shown.

 [0009]

[Example] 133 Xe gas 200 MBq was transported to the 3.8-I. sample cylinder by the vacuum line. The same cylinder was filled up also with the 129 Xe enriched isotope of about 3 cm 3 as an index of the mass in mass separation. This cylinder was connected to the Nielsen type ion source of an ion-implantation machine, and the ion implantation of the 133 Xe was carried out to the fullerene which is a target in 40 keV. The target was created by two kinds of methods. The 1st considered CsCl (0.8g) as the support, it carried out application-of-pressure molding of what mixed the fullerene (C_{60}) of 50 mg,

and Csl of 18 mg, and produced the pellet (diameter 18 mm). the 2nd uses an evaporation apparatus -- Ni foils (25x25 mm) -- fullerene (C₆₀) -- about -- that of which 1.5 mum vacuum evaporation was done was targeted. When using this Ni-foils evaporation target, the slit which applied the voltage of + to the front face of a target as a reduction gear was installed, and 0.5 - 3 keV was made to slow down 133 Xe⁺ ion. These targets were dissolved in o-dichlorobenzene after the ion implantation, and high performance chromatography (HPLC) analyzed fullerene. The eluate was isolated preparatively and the radioactivity of Xe-133 was measured. Since the peak of the fullerene by HPLC and the peak of Xe-133 in an eluate were in agreement, it was checked that Xe-133 intension fullerene is generating. The rate of the radioactivity of Xe-133 included by the fullerene to the radioactivity of all the Xe-133 by which the ion implantation was carried out to the target was computed as capture probability. [Equation 1]

(6.50 (水平(水))= Xe-133 (内型フラーレンの放射器 ターグットにイオン法人されたXe-133の放射器

When the pellet created on the conditions mentioned above was used, capture probability showed the maximum (0.28%) at the present stage. Isolation of the Xe-133 intension fullerene from the fullerene which is a target, It is theoretically possible by using HPLC (DiCamillo B. A. etal., J. Phys. Chem. 100 (22), and 9197-9201 (2000)). Although the example of the ion implantation of Xe-133 was shown here, if it is an ionizable isotope, all the isotope intension fullerene of them can be theoretically made using this invention.

[0010]

[Effect of the Invention]By this invention, the isotope intension fullerene of arbitrary fullerene kinds can be made, excluding any isotopes other than the purpose. The created isotope intension fullerene may be use by nuclear medicine. It is thought that it can be used as a remedy of cancer if Xe-133 intension fullerene is changed into a chemical form which gather for cancer, since Xe-133 of an example is a beta line emission nuclide.

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

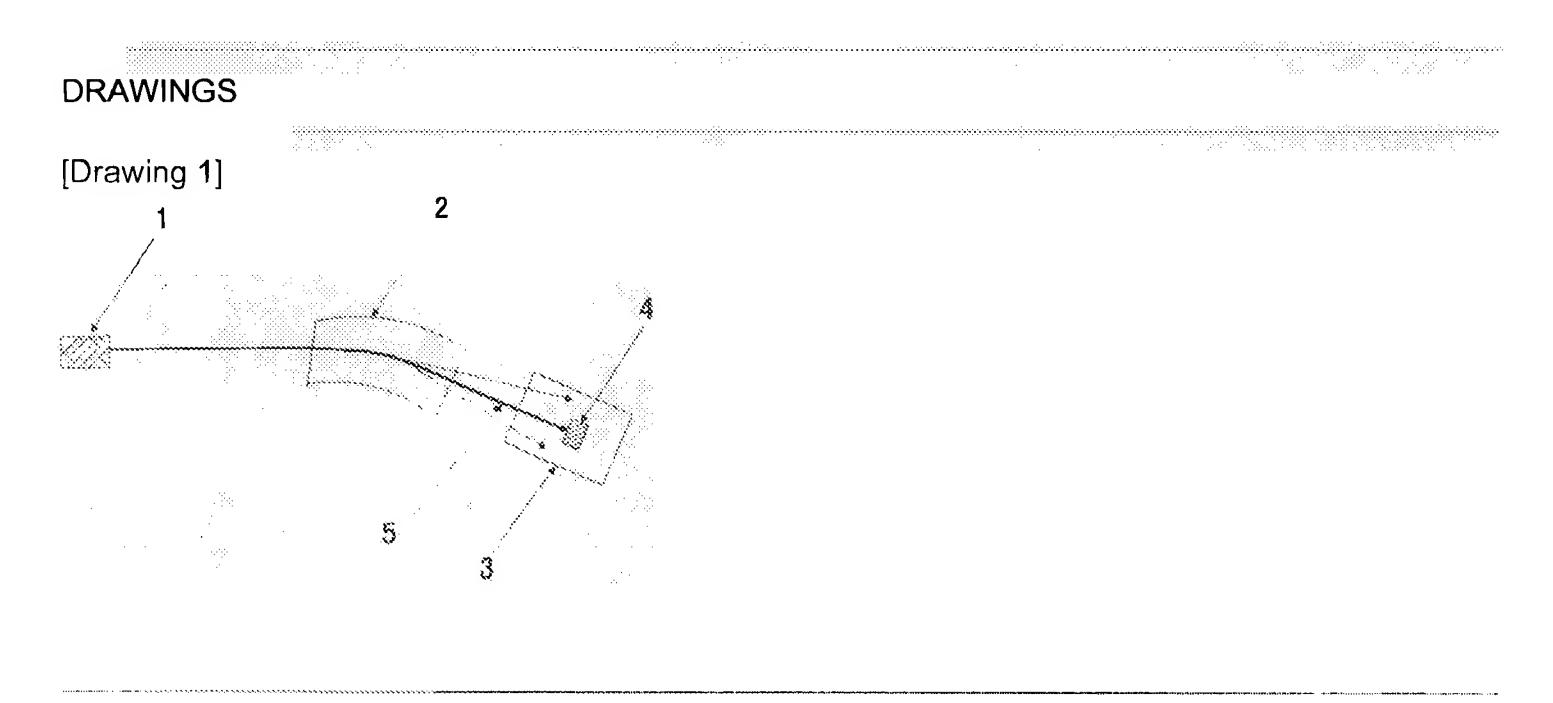
[Drawing 1]It is a figure showing the ion-implantation machine for manufacturing isotope intension fullerene.

[Description of Notations]

- 1 lon source
- 2 Mass analysis magnet
- 3 Target chamber
- 4 Target
- 5 The target isotope ion beam

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.



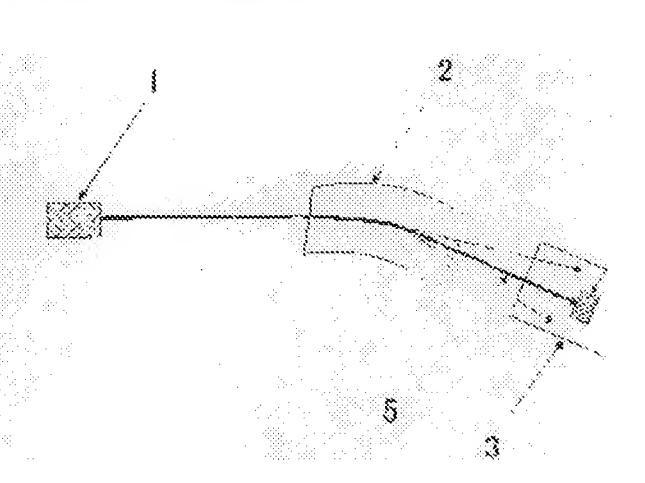
四公公開特許公報(4) (11)特殊四颗公開發等 (19)日本国校研究 (19) 特別2012-255518 (P2002 - 255518A)(43)(2)(11) FRILT 9 HILE (2002. 9 }; } (51) mi CL 類別記号 7-13-1:52 COIB 31/02 101 COIB 31/02 1018 40046

		XWEW.	京都派 海水準の数1 OL (全 3
(21)()((12)	\$6 98 \$2510.1 — \$434.1(F280.1 — \$4344)	(71) (担) (17)	01×100111347
			uxixtjeyev
(22)出級旧	平成13年2月28日(2001.2.25)		· 果成数子代则区内参加2T目2#29
		(72) 18 91 1	WI W
科計區實別条數 1 項務用申請有 0 平成12年 9 月 12日 日本於針化学会発行の「日本放射化学会誌 第 1 多別順			MANGAMINGENIZZAM FIAM: HANGAMINAN
21 (CK)		(72) 58 88 83	an st
			MULICALINE PRIZZE PARI POURISMONIN
		人理分(47)	1(8)(59)(85
			乔理士 社本 一关 (外5名)
			R *Rt

(54) 【新明の名称】 イオンは入法による所能元素器別的原子内型フラーレンの散進方法

【課題】 イオン注入法によりがが性間に元素等をフラーレンに自己させることに関する。 【解決等的】 整置の折フクタン 1 を原題したイオン主人器を用い、フラーレンによりフラーレン語機能をなった。 タートとして放射性間位元素等の特定同位元素をイオン主主人でありますの言う。

(57) [#43]



(2)

###2002-255f

【特許請求の範囲】

【請求項1】 質置分析マグネットを装備したイオン注入器を用い、フラーレンおよびフラーレン誘導体をターゲットとして放射性同位元素等の特定同位元素をイオン注入することを特徴とする原子内包フラーレンの製造方法。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、放射性同位元素等をフラーレンに内包させることに関するものであり、同位元素内包フラーレンを製造するためにイオン注入法を用いることを特徴とするものである。

[0002]

【従来の技術】イオン注入法を用いた内包フラーレンの製造方法としては、Li等のアルカリ元素内包フラーレン(Tellgmann R. et al., Nature 382、407-408(1996)、N内包フラーレン(Wendinger A. et al., Appl. Phys. A 65, 287-292(1998))およびHe、Ne内包フラーレン(Shimshi R. et al., J. Am. Chem. Soc. 119, 1163-1164(1997))などが報告されている。これらはすべる。非同位元素選択的内包フラーレンに関した製造方法である。また、キセノンの放射性同位体であるXe-127を内包したフラーレンの製造方法は、***I(d, 2n) ***Xe 反応における反携エネルギーを利用したもの(Chtsukn T. et al., Physical Review Letters 81,967-970(1998))が報告されている。

【りりり3】しかし、核反応を用いた場合、目的以外の 放射性同位元素内包フラーレンが生成する可能性があ る。さらに、目的の同位元素を炭素障電極に含ませてお き、アーク放電法により同位元素内包フラーレンを製造 する方法が報告されている(Amber F., J. Radnoanal、N ucl. Chem. 243、21-25(2000))。しかし、この方法 で作られた金属内包フラーレンのフラーレン種は、多種 類生成してしまい、任意のフラーレン種の内包フラーレンを作ることができない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術として、イオン注入によるLi、N. HeおよびNe内包フラーレンの製造方法が報告されているが、これらはすべて非同位元素。 選択的なものである。また、核反応を用いた放射性同位。 元素内包フラーレンの製造方法が報告されているが、目

[0006]

【課題を収集するための手段】を発明は、第一の 第の子主ン注入が可能なった。注入器を用いるに のできる。さらに、子子語入のケーケットとし のフラーレン数を選べることから、注意のフラー の内容フラーレンを製造することができる。

10007)

本業別では、第一の間に元素をくす。ほ人数(数) 砂量分析マグネットを含えたくす。ほ人数(数) いろ、リアにそのくす。ほ人数の数果を示す。く 大器のターゲットをいって、「) ご算業中でイオン注入をいう。このとき、(す 生成された種ののくす。はイオンとして発 マクネートが、強けれる。ここで(す)と一ムの後 別からわれるため、ターケットがは13月的の同位う オンピームのたけかくオン注入される。

イタン注入のターケットとしては、フラーレー語 さめて注意のフラーレー語を用いる。また、また いるイナン注入器は含まび回じすると無うが の 編集の MAYでお勧させるか。回はで素内もフ とを製造する上で、回位で素(オング入時ます) しては高すさらため、そのイナーの概念が必要で そとで、以下に示する建造の無から2つの方法を外 る。

(1)フラーレンと構建的(Csi等の物素)を任?) 台で開台してペレット状のターケットを作成し - 間位元素のイオン住入を行う。

(2)・金属をスプラーレンを開催して開催してア (1900年、この開催シーケートの開催し続き集集 (2)単圧を2/2/2、2)・1 全計を15円に元素である。(2) 注入を15つ、以下に対対は同じ元素である。(2) にあり、本名時の具は100(単版例をデオ

[00009]

「実施が) *** / *** / *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***

特開2002-2556

置して''' Ye' イオンかり、5~3 kelに原理させた。 イオン 注入後、これらのターケットをみジクロロペンを少に窓 凝し、高速液体をロマトグラフィー (HMC) によりフラ ーレンを分析した。また 溶出液を分取して、Xe-13300 数射能を測定した。HMCによるフラーレンのビークと落 世級中のX=1330ビークが一致したことから、Xe-13371米

・ 米包フラーレンが生成していることがME認された。 ターケットにイオンエスされたすべてのxe-13300 に対するフラーレンに内容された26-132の放射能 を指摘確率として異問した。

X

上述した条件で作成したペレットを用いた時の指摘確率 は 現段階で最大値(0.28%)を示した。なわ ターゲー ットであるフラーレンからのXe-133内包フラーレンの集 数(2 PPCを無いることにより(OnCamillo B. A. er a 1., J. Phys. Chem. 100(72), 9197-9201 (2000)) 原建 的には可能である。また ここではXe-133のイオン注 入の例を示したが、イオン化が可能な同位元素であれ は、原理的にほぞれらすべての同位元素内包フラーレン を本等明を用いて作ることができる。

(00101

「発明の効果」本発明により、目的以外の同位元素を含 表す。かつ任意のフラーレン値の同じ元素内型フラーレ 20 3・・・・・ ターゲット シを作ることができる。さらに、作成した目的元素内包× 5・・・・・ 目的の同位元素イオンビーム

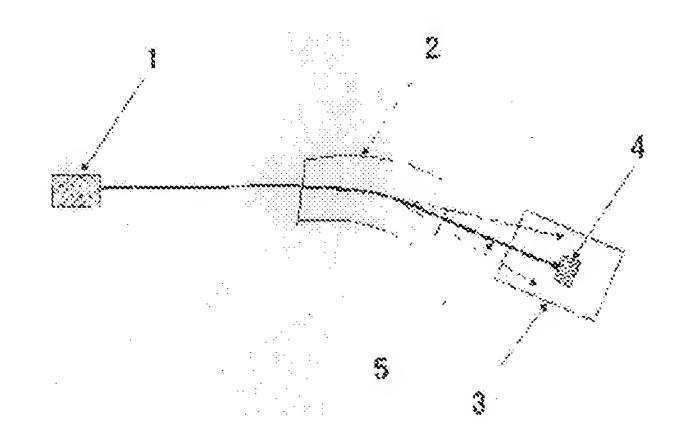
※フラーレンは該医学での利用の可能性がある。実 10 Xe-133は8 波波器接続であるため、Xe-1337930: - レンを窓に集まるような化学形に変換すれば、原 薬として利用できると考えられる。

【図面の器章な説明】

【図1】 間位元素的包クラーレンを製造するた オン狂入器を示した図である。

【符号の說明】

[21]



群馬県高崎市総長町1237番地

111